

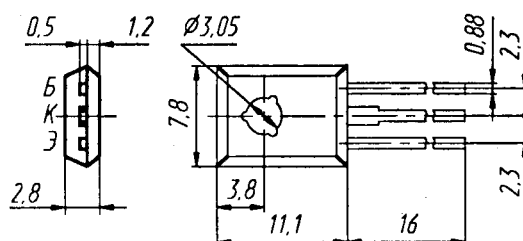
## КТ816А, КТ816Б, КТ816В, КТ816Г, КТ816А2

Транзисторы кремниевые мезазпитаксиально-планарные структуры *p-n-p* усилительные. Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, операционных и дифференциальных усилителях, преобразователях и импульсных устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 1 г.

Изготовители — акционерное общество «Кремний», г. Брянск, завод «Искра», г. Ульяновск.

КТ816(А-Г), КТ816А2



### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{КБ} = 2$  В,  $I_3 = 1$  А, не менее:

$T_K = +25$  °С:

КТ816А, КТ816Б, КТ816В, КТ816Г .....	25
КТ816А2 .....	200

$T_K = +100$  °С для КТ816А, КТ816Б, КТ816В, КТ816Г .....

25

$T_K = -40$  °С для КТ816А, КТ816Б, КТ816В, КТ816Г .....

15

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{КБ} = 10$  В,  $I_3 = 0,25$  А, не менее .....

3 МГц

Граничное напряжение при  $I_3 = 0,1$  А, не менее:

КТ816А, КТ816А2 .....	25 В
КТ816Б .....	45 В
КТ816В .....	60 В
КТ816Г .....	80 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при  $I_K = 3$  А,  $I_Б = 0,3$  А, не более .....

0,6 В

типичное значение .....

0,33\* В

Напряжение насыщения база—эмиттер при  $I_K = 3$  А,  $I_Б = 0,3$  А, не более .....

1,5 В

типичное значение .....

0,92\* В

Обратный ток коллектора, не более:

$T = +25$  °С:

КТ816А, КТ816А2 при $U_{КБ} = 25$ В .....	0,1 мА
КТ816Б при $U_{КБ} = 45$ В .....	0,1 мА
КТ816В при $U_{КБ} = 60$ В .....	0,1 мА
КТ816Г при $U_{КБ} = 80$ В .....	0,1 мА

$T = +100$  °С:

КТ816А при $U_{КБ} = 25$ В .....	3 мА
КТ816Б при $U_{КБ} = 45$ В .....	3 мА
КТ816В при $U_{КБ} = 60$ В .....	3 мА
КТ816Г при $U_{КБ} = 80$ В .....	3 мА

Емкость коллекторного перехода

при  $U_{КБ} = 10$  В, типичное значение .....

60\* пФ

Емкость эмиттерного перехода при  $U_{ЭБ} = 0,5$  В,

типичное значение .....

115\* пФ

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер:

$R_{БЭ} = \infty$ :

КТ816А, КТ816А2 .....	25 В
КТ816Б .....	45 В
КТ816В .....	60 В
КТ816Г .....	80 В

$R_{БЭ} = 1 \text{ кОм}$ :

КТ816А, КТ816А2 .....	40 В
КТ816Б .....	45 В
КТ816В .....	60 В
КТ816Г .....	100 В

Постоянное напряжение база—эмиттер .....

5 В

Постоянный ток коллектора .....

3 А

Импульсный ток коллектора при  $t_{и} = 20 \text{ мс}$ ,

$Q = 100$  .....

6 А

Постоянный ток базы .....

1 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллек-

тора<sup>1</sup> при  $T_{к} = -40...+25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ :

с теплоотводом .....

25 Вт

без теплоотвода .....

1 Вт

Температура  $p$ - $n$  перехода .....

+150  $^{\circ}\text{C}$

Температура окружающей среды .....

-40...  $T_{к} =$

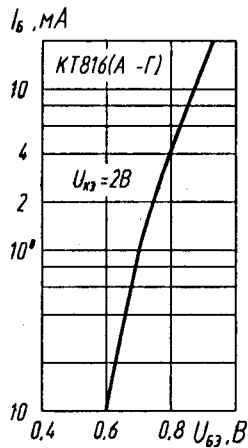
= +100  $^{\circ}\text{C}$

<sup>1</sup> При  $T_{к} > +25 \text{ }^{\circ}\text{C}$  максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора уменьшается линейно на 0,2 Вт/ $^{\circ}\text{C}$  с теплоотводом.

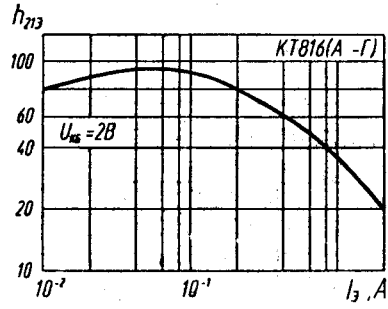
Изгиб выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5...2 мм. При этом должны быть приняты меры, исключающие возможность передачи усилий на корпус. Изгиб в плоскости выводов не допускается.

При монтаже транзисторов на теплоотвод крутящий момент нажима не должен превышать 70 Н·см.

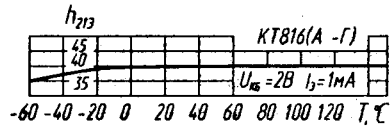
Пайка выводов транзисторов рекомендуется не ближе 5 мм от корпуса. При пайке жало паяльника должно быть заземлено.



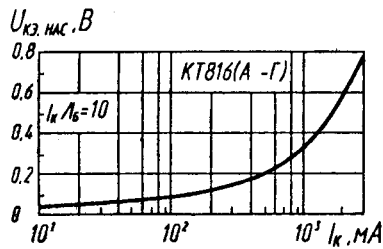
Входная характеристика



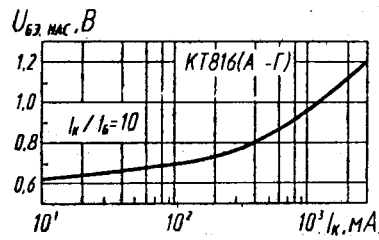
Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



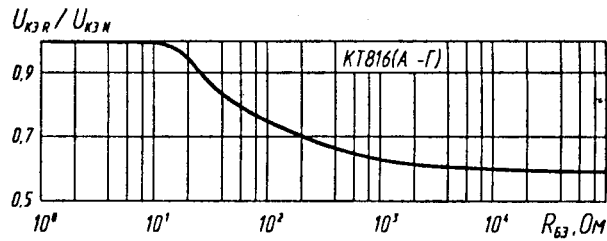
Зависимость статического коэффициента передачи тока от температуры



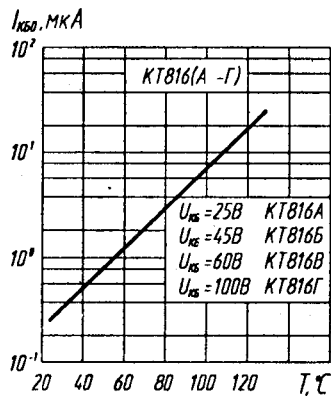
Зависимость напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения база—эмиттер от тока коллектора



Зависимость постоянного напряжения коллектор—эмиттер от сопротивления база—эмиттер



Зависимость обратного тока коллектора от температуры